



技术交流

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[an error occurred while processing this directive] | [an error occurred while processing this directive]

^{32}Si 半衰期的加速器质谱测量方法研究

郑国文¹; 何明¹; 姜山¹; 董克君¹; 李振宇¹; 胡豪¹; 李恒²; 武绍勇¹

1. 中国原子能科学研究院, 北京102413; 2. 广西大学物理科学与工程技术学院, 广西 南宁530004

Measurement on the Half-Life of ^{32}Si by AMS at CIAE

ZHENG Guo-wen¹; HE Ming¹; JIANG Shan¹; DONG Ke-jun¹; LI Zhen-yu¹; HU Hao¹; LI Heng²; WU Shao-yong¹

1. China Institute of Atomic Energy, Beijing 102413, China; 2. Academy of Physics, Guangxi University, Nanning 530004, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献 \(13\)](#)

[相关文章 \(7\)](#)

?

版权所有 © 2013 《质谱学报》编辑部

通讯地址: 北京275信箱65分箱 邮政编码: 102413

Tel: (010)69357734 Fax: 010-69357285 E-mail: jcmss401@163.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn